



	<p>Ф.И.О. Атамуратова Зухра Атабековна</p> <p>ДОЛЖНОСТЬ Старший Преподаватель</p> <p>ТЕЛ: +99897 510 64 00</p> <p>Е – mail: zuhra.atamuratova03@gmail.com ;</p> <p>ТЕЛЕФОН</p> <p>ОРГАНИЗАЦИИ: +99862 2246700</p> <p>АДРЕС</p> <p>ОРГАНИЗАЦИИ: г.Ургенч, ул.Х.Олимджана 14. 220100</p>
<p>ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНЬ</p>	<p>2005- 2009: Ургенческий государственный университет.</p> <p>2009-2011 : Ташкентского государственного университета.</p> <p>2011 -2019: Учительница кафедры физики Ургенческого государственного университета.</p> <p>2019- Учительница кафедры физики Ургенческого государственного университета.</p>
<p>СПЕЦИАЛЬНОСТЬ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Физика.
<p>ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Моделирование полупроводниковых приборов, основание полупроводниковые электроники
<p>ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:</p>	<p>Моделирование полупроводниковых приборов, полупроводниковые многослойные структуры, МОП структуры, МОП транзисторы, FinFET транзисторы, беспереходные МОП транзисторы, короткоканальные эффекты в наноразмерных МОП транзисторах, случайные телеграфные шумы, радиационная физика полупроводниковых приборов.</p>
<p>ПРОЕКТЫ:</p>	<p>2017-2020. “ New approach to investigation of the nature and lateral distribution of the defects at Si-SiO₂ interface and in the oxide layer”. Ministry of innovational development of Uzbekistan.</p> <p>2021-2023. Совместный Индийско-Узбекский проект “Self Heating Effect on stacked Nanosheet Field Effect Transistor”</p>
<p>ПУБЛИКАЦИИ</p>	<p>1. A.E. Atamuratov, R. Granzner , M. Kittler, Z. Atamuratova, M. Halillaev, F. Schwierz . Simulation of Random Telegraph Noise in nanometer nMOSFET induced by interface and oxide trapped charge. NATO Advanced Research Workshop on Low Dimensional Functional Materials, October 15-19, 2012, Tashkent</p> <p>2. A.E. Atamuratov , Z. Atamuratova, M. Halillaev, G. Ghione. Simulation of carrier</p>

- distribution in nanometer MNOSFET with single charge trapped in oxide and at $\text{SiO}_2 - \text{Si}_3\text{N}_4$ interface. Materials of International conference Low dimensional nanoscale systems: quantum effects, particle transport and advanced materials. November 6-7,2012, Tashkent.
- 3.** Matyakubov H., Atamuratova Z. A., Abdikarimov A., Halillaev M., Atamuratov A.E. The method of estimation of single trapped charge position in nanometer MNOSFET oxide layer and Si-SiO₂ interface. Materials of International conference Fundamental and Applied Problems of Physics November 14-16,2013, Tashkent.
- 4.** A.E.Atamuratov, U.A.Aminov, Z.A. Atamuratova, M. Halillaev, A. Abdikarimov , H. Matyakubov. The lateral capacitance of nanometer MNOSFET with a single charge trapped in oxide layer or at SiO₂ - Si₃N₄ interface. Nanosystems: physics, chemistry, mathematics, 2015, 6 (6), p. 837–842
- 5.**A.E. Atamuratov, A. Abdikarimov, M. Khalilloev, Z. A. Atamuratova , R. Rahmanov, A. Garcia-Loureiro, A. Yusupov, Simulation study of dibl effect in 25 nm soi-finfet with the different body shape, Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2017. 8 (1), p. 71–74
- 6.** A. E. Atamuratov, , M. Khalilloev, , A. Abdikarimov, , Z.A. Atamuratova, M. Kittler, R. Granzner, F. Schwierz, Influence of non-uniform lateral interface defects distribution to the current-voltage characteristic of MOSFET .Nanosystems: physics, chemistry, mathematics, 2017, 8 (1), p. 75–78.
- 7.** Atamuratov A.E.,Abdikarimov A., Atamuratova Z.A., Xolillaev M., Yusupov A. Collection of papers (Urgench state university). Actual problems of modern science, education and training in the region 8-12 page, N1, 2017
- 8.** A.E. Atamuratov, Z.A. Atamuratova, A. Yusupov, A. Ghani,. Characterising lateral capacitance of MNOSFET with localised trapped charge in nitride layer. Results in Physics, V.11, 2018, pp. 656–658..
- 9.**Z. A. Atamuratova, A. Yusupov, B. O. Khalikberdiev, and A. E. Atamuratov Anomalous Behavior of Lateral C–V Characteristic of an MNOS Transistor with an Embedded Local Charge in the Nitride Layer. Technical Physics, 2019, Vol. 64, No. 7, pp. 1006–1009.
- 10.** Atabek E. Atamuratov, Ahmed Yusupov, Zukhra A. Atamuratova, Jean Chamberlain Chedjou and Kyamakya Kyandoghère. Lateral Capacitance–Voltage Method of NanoMOSFET for Detecting the Hot Carrier Injection. Appl. Sci. 2020, 10(21), 7935; doi:10.3390/app10217935